BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-246347

(43) Date of publication of application: 19.09.1997

(51)Int.CI.

H01L 21/68

H01L 21/02

(21)Application number : **08-044896**

(71)Applicant: APPLIED MATERIALS INC

(22) Date of filing:

01.03.1996

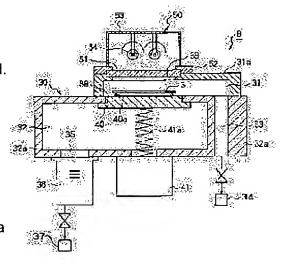
(72)Inventor: JINBO TAKESHI

(54) MULTICHAMBER WAFER TREATMENT SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a low-priced wafer conveying device of a multichamber wafer treatment system in which a throughput is improved and an excellent surface treatment can be conducted.

SOLUTION: A load lock chamber 8 is composed of the first load lock chamber 31 to be connected to a load station and the second load lock chamber 32 to be connected to a transfer chamber. These load lock chambers 31 and 32 can be isolated or communicated with each other by a stage 40 where a sheet of wafer 3 is mounted. The first load lock chamber 31 is formed in small cubic volume, and the second load lock chamber 32 is formed in a high



vacuum state. A degas heater 54 is provided on the load lock chamber 8. As the second load lock chamber 32 is a double vacuum chamber, the entering of atmospheric air into a transfer chamber is greatly reduced, and as degassing is performed in the treatment time of the process chamber, a throughput is not decreased and gas contamination is not generated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

01.03.1996

[Date of sending the examiner's decision of 22.09.1998]

rejection]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2937846

[Date of registration] 11.06.1999

[Number of appeal against examiner's 10-20327

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against 18.12.1998

examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許/广(JP)

四公外開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号

特開平9-246347

(48)公開日 平成9年(1997)9月19日

(51) Int.C1°	資別配号	广内查理骨号	P I		技術表示值所
HO1L 21/68			HOll	21/68	A
21/02	14-		•	21/02	Z

審査請求 有 請求項の数48 OL (全 12 頁)

(21) 出職分子 特職平8 - 44896 (71) 出職人 390040660 アプライド

(22)出版日 平成8年(1996)8月1日

アプライド マテリアルズ インコーポレ イテッド

APPLIED MATERIALS, I NCORPORATED

アメリカ合衆国 カリフォルニア州

95064 サンタ クララ パウアーズ ア ベニュー 3050

(72)発明者 神保 載

千葉原成田市新泉14-8 新名平工業団地内 アプライド マテリアルズ ジャバン

#SCATE!内

(74)代理人 中理士 長谷川 労働 (9)3名)

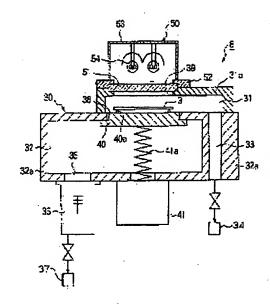
(54) 【発明の名称】 マルチチャンパウェハ処理システム

(57)【要約】

【課題】 スルーブットが向上し、良好な表面処理を行うことができる安価なマルチチャンパウェハ処理システムのウェハ搬送装置とする。

【解決手段】 ロードロックチャンパ8をロードステーションに接続される第1のロードロックチャンパ31とトランスファチャンパに接続される第2のロードロックチャンパ32とに分割構成する。これらチャンパ31、32を、一枚のウェハ3を搭載したステージ40により遮断および速通可能とする。第1のロードロックチャン

パ31を小さな容様に形成し、第2のロードロックチャンパ32を高真空とする。ロードロックチャンパ8にデガスヒータ54を設ける。2重の真空室であるので、トランスファチャンパ内への大気の持ち込みは激減され、プロセスチャンパでの処理時間中にデガスまで行うので、スループットを落とすことなく、ガスコンタミネーションも生じない。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウェハを収納したウェハカセットを配置するロードステーションと、前記ウェハに所定の処理を行うプロセスチャンパを隣設するとともに、前記ウェハの搬送を行うトランスファロボットを具備したトランスファチャンパと、前記ロードステーションと前記トランスファチャンパとの間に配置され、前記ロードステーションから受け取った前記ウェハを前記トランスファロボットに受け渡すロードロックチャンパとを備えたマルチチャンパウェハ処理システムのウェハ搬送装置であって、

前記ロードロックチャンパの真空室を前記ロードステーションに接続される第1のロードロックチャンパと前記トランスファチャンパに接続される第2のロードロックチャンパとに分割構成するとともに、

前記第1のロードロックチャンパと前記第2のロードロックチャンパとを遮断および連通可能とし、

前記第1のロードロックチャンパを前記第2のロードロックチャンパより小さな容積に形成し、

前記第2のロードロックチャンパを前記第1のロードロックチャンパより高高空とし、

搭載した一枚の前記ウェハを前記第1のロードロックチャンパから前記第2のロードロックチャンパに移動する ステージを設け、

前記ロードロックチャンパに前記ウェハのデガスを行う デガスヒータを設けたことを特徴とするマルチチャンパ ウェハ処理システムのウェハ搬送装置。

【請求項 2】 対記第1および第2のロードロックチャンパを上下に配置し、対記ステージにより対記第1のロードロックチャンパと対記第2のロードロックチャンパとを速断および連通可能としたことを特徴とする請求項1記載のマルチチャンパウェハ処理システムのウェハ撤送結60。

【請求項 4】 大条圧の圧力レベルの下に複数枚のウェ ハを収納するためのウェハカセットが設けられるロード ステーションと、

前記ロードステーションと選択的に通気状態または非通 気状態となるように設けられた、一枚のウェハを収納す るに必要な容様を有する第1のロードロックチャンパ と、

前記第1のロードロックチャンパを第1の圧力レベルまで選圧するための第1の排気手段と、

前記第1のロードロックチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられた。第2のロードロックチャンパと、

前記第2のロードロックチャンパを前記第1の圧力レベルより真空度の高い第2の圧力レベルまで減圧するため

の第2の排気手段と、

前記第2のロードロックチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられ、前記第2のロードロックチャンパから転送されてくるウェハを所要のチャンパに転送するためのトランスファチャンパと、

前記トランスファチャンパと選択的に通気状態または非 通気状態となるように設けられ、前記トランスファチャ ンパから転送されてくるウェバに対して所要の処理を行 うプロセスチャンパとを備え、

前記ロードステーションと前記第1のロードロックチャンパとの間のウェハの転送および前記チャンパ間のウェハの転送はウェハー枚ずつ行われることを特徴とするマルチチャンパウェハ処理システム。

【諸求項5】 前記第1のロードロックチャンパは前記第2のロードロックチャンパの上部に設けられており、ウェハを搭載するためのステージ機構の上下運動に従い、前記第1のロードロックチャンパと前記第2のロードロックチャンパとは通気状態または非通気状態となることを特徴とする諸求項4記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項6】 前記ロードステーションと前記第1のロードロックチャンパとが非通気状態となった後に、前記第1のロードロックチャンパと第2のロードロックチャンパとは通気状態となることを特徴とする請求項4記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項7】 前記第1のロードロックチャンパの上部に設けられたデガス手段を更に含み、前記第1のロードロックチャンパと第2のロードロックチャンパとが通気状態にあるときにデガス処理を行うことを特徴とする請求項5記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項8】 前記デガス手段はハロゲンランブからなるランブ加熱手段を含むことを特徴とする請求項7記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項9】 前記第1のロードロックチャンパはロ・5~0.8リットルの容積を有することを特徴とする請求項4記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項10】前記第1の排気手段は前記第1のロードロックチャンパの側壁に形成された排気管路を介して接続されたラフポンプを含むことを特徴とする請求項4記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項11】 前記第1の圧力レベルは50mTorr程度の実空状態であることを特徴とする請求項4記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【諸求項12】 前記第2のロードロックチャンパは約10リットルの容様を有することを特徴とする諸求項4記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項13】 前記第2の排氨手段は前記第2のロードロックチャンパの底板に形成された開口部を介して接続されたターボボンプおよびラフボンプを含むことを特徴とする請求項4記載のマルチチャンパウェハ処理シス

テム

【請求項14】 前記第2の圧力レベルは10-6forr程度の真空状態であることを特徴とする請求項4記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項 15】 前記トランスファチャンパは 10-7~ 10-8forr程度まで真空排気 されていることを特徴とする請求項 4記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項16】 前記プロセスチャンパは10-97orf程 度まで実空排気されていることを特徴とする請求項4記 載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【諸求項 17】 大気圧の圧力レベルの下に複数核のウェハを収納するためのウェハカセットが設けられるロードステーションから、前記ロードステーションと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられた、一枚のウェハを収納するのに必要な容積を有する第1のロードロックチャンパへ一枚のウェハを転送し、前記第1のロードロックチャンパを第1の圧力レベルま

前記第1のロードロックチャンパから、前記第1のロードロックチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられるとともに、前記第1の圧力レベルより真空度の高い第2の圧力レベルまで減圧された第2のロードロックチャンパへ、前記一枚のウェハを転送

が記第2のロードロックチャンパから、前記第2のロードロックチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられるとともに、前記第2の圧力レベルより真空度の高い第3の圧力レベルまで減圧されたトランスファチャンパへ、前記一枚のウェバを転送し、前記第2のロードロックチャンパと前記トランスファチャンパとの闘を非通気状態とし

前記トランスファチャンパから、前記トランスファチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように 設けられたプロセスチャンパへ、前記一枚のウェハを転 送するマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェ ハ椴入方法。

【請求項 1.8】 前記第1のロードロックチャンパから 前記第2のロードロックチャンパへのウェハの転送を開 始した後、ウェハに対してデガス処理を行うことを特徴 とする請求項17記載のマルチチャンパウェハ処理シス テムにおけるウェハ搬入方法。

【請求項19】 前記第1のロードロックチャンパは 0、5~0、8リットルの容様を有することを特徴とす る請求項17記載のマルチチャンパウェハ処理システム におけるウェハ搬入方法。

【請求項20】 前記第1の圧力レベルは50mTorr程度の真空状態であることを特徴とする請求項17記載のマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ推入方法。

【請求項21】 前記第2のロードロックチャンパは約

1 ロリットルの容積を有することを特徴とする諸求項1 7 記載のマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ換入方法。

【請求項22】 前記第2の圧力レベルは10-6forr程度の真空状態であることを特徴とする請求項17記載のマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ搬入方法。

【請求項23】 前記トランスファチャンパは10-7~10-8forr程度まで真空排気されていることを特徴とする請求項17記載のマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ級入方法。

【請求項24】 前記プロセスチャンパは10-97or程 度まで真空排気されていることを特徴とする請求項17 記載のマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェ ハ椴入方法。

【請求項25】 トランスファチャンパとロードズテーションとの間に配置されるアンロードロックチャンパを第1の圧力レベルとされる第1のアンロードロックチャンパと第2の圧力レベルとされる第2のアンロードロックチャンパとで構成し、

プロセスチャンパから、前記プロセスチャンパと選択的 に通気状態または非通気状態となるように設けられたト ランスファチャンパヘー枚のウェハを転送し、

前記プロセスチャンパと前記トランスファチャンパとの 間を非通気状態と し

前記トランスファチャンパから、前記トランスファチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられるとともに、前記トランスファチャンパ内の圧力レベルより真空度の低い前記第2の圧力レベルまで減圧された前記第2のアンロードロックチャンパへ、前記ー枚のウェハを転送し、

前記第2のアンロードロックチャンパから、前記第2のアンロードロックチャンパと選択的に通気状態または非 通気状態となるように設けられた前記第1のアンロード ロックチャンパへ、前記一枚のウェハを軽送し、

前記第1のアンロードロックチャンパと前記第2のアン ロードロックチャンパとの間を非通気状態とし、

前記第 1 のアンロードロックチャンパの前記第 1 の圧力 レベルを大気圧の圧力レベルまで昇圧し、

前記第1のアンロードロックチャンパから、前記第1の アンロードロックチャンパと選択的に通気状態または非 通気状態となるように設けられた前記ロードステーショ ンへ、前記一枚のウェハを転送するマルチチャンパウェ ハ処理システムにおけるウェハ搬出方法。

【請求項26】 前記第1のアンロードロックチャンパを大気圧の圧力レベルまで昇圧した後、第1のアンロードロックチャンパ内のウェハを冷却することを特徴とする請求項25記載のマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ撤出方法。

【請求項27】 前記第1のアンロードロックチャンバ

は D: 5~0. 8リットルの容様を有することを特徴とする詩求項25記載のマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ搬出方法。

【請求項28】 前記第2の圧力レベルは10-6forr程 度の真空状態であることを特徴とする請求項25記載の マルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ搬出 方法。

【請求項29】 前記第2のアンロードロックチャンパは約10リットルの容積を有することを特徴とする請求項25記載のマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ搬出方法。

【請求項30】 前記トランスファチャンパは10-7~ 10-8forr程度まで真空排気されていることを特徴とする請求項25記載のマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ搬出方法。

【請求項31】 前記プロセスチャンパは10-97or程度まで真空排気されていることを特徴とする請求項25記載のマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ称出方法。

【請求項32】 大気圧の圧力レベルの下に複数枚のウェハを収納するためのウェハカセットが設けられるロードステーションと、

前記ロードステーションと選択的に適気状態または非通 気状態となるように設けられ、前記ロードステーション から転送されてくる一枚のウェハを収容するためのロー ドロックチャンパと、

前記ロードロックチャンパを大気圧より真空度の高い圧 カレベルまで選圧するための排気手段と、

前記ロードロックチャンパ内に収容されたウェハに対してデガス処理を行うデガス手段と

前記ロードロックチャンパと選択的に通気状態または非 通気状態となるように設けられ、前記ロードロックチャ ンパから転送されてくる一枚のウェハを所要のチャンパ に転送するためのトランスファチャンパと、

耐記トランスファチャンパと選択的に通気状態または非 通気状態となるように設けられ、耐記トランスファチャ ンパから転送されてくる一枚のウェハに対して所要の処 理を行うプロセスチャンパとを備えたことを特徴とする マルチチャンパウェハ処理システム。

【諸求項33】 前記ロードロックチャンパは第1のロードロックチャンパと第2のロードロックチャンパとを含み、前記第1のロードロックチャンパは前記ロードステーションおよび前記第2のロードロックチャンバの存々に選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられるとともに、前記ロードステーションから転送されてくる一枚のウェハを収容し、前記第2のロードロックチャンパは前記第1のロードロックチャンパおよび前記トランスファチャンパの各々に選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられるとともに、前記第1のロードロックチャンパから転送されてくる一枚のウ

ェハを収容することを特徴とする請求項32記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項34】 前記損気手段は前記ロードステーションと前記第1のロードロックチャンパとが非通気状態となった後に、前記第1のロードロックチャンパを大気圧より真空度の高い第1の圧力レベルとなるまで減圧することを特徴とする請求項33記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【諸求項35】 前記損気手段は前記第2のロードロックチャンパを前記第1の圧力レベルより真空度の高い第2の圧力レベルとなるまで減圧することを特徴とする語 求項34記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項36】 前記ロードステーションと前記第1のロードロックチャンパとが非適気状態となった後に、前記第1のロードロックチャンパと前記第2のロードロックチャンパとは通気状態となることを特徴とする請求項35記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項37】 前記デガス手段はハロゲンランブからなるランブ加熱手段を含むことを特徴とする請求項32記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【諸求項38】 前記第1のロードロックチャンパは 0.5~0.8リットルの容核を有することを特徴とす る諸求項33記載のマルチチャンパウェハ処理システ

【請求項39】 前記排気手度は前記第1のロードロックチャンパの側壁に形成された排気管路を介して接続されたラフポンプを含むことを特徴とする請求項33記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【諸求項40】 前記第1の圧力レベルは50mTorr程 度の真空状態であることを特徴とする諸求項34記載の マルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項41】 前記第2のロードロックチャンパは約 1.ロリットルの容様を有することを特徴とする請求項3 3記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項42】 前記排気手段は前記第2のロードロックチャンパの底板に形成された開口部を介して接続されたターボボンブおよびラフボンブを含むことを特徴とする請求項33記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項43】 前記第2の圧力レベルは10-6forr程度の真空状態であることを特徴とする請求項35記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項44】 前記トランスファチャンパは1ロ−7~ 1:ロ−8Torr程度まで真空排気されていることを特徴とす る詰求項32記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項45】 前記プロセスチャンパは10-97orr程 度まで真空排気されていることを特徴とする請求項32 記載のマルチチャンパウェハ処理システム。

【請求項45】 大気圧の圧力レベルの下に複数枚のウ

エハを収納するためのウェハカセットが設けられるロードステーションから、前記ロードステーションと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられた、 一枚のウェハを収納するのに必要な容積を有するロードロックチャンパへ一枚のウェハを転送し、

前記ロードステーションと前記ロードロックチャンパと の間を非通気状態とし、

前記ロードロックチャンパを大気圧の圧力レベルより真 空度の高い第1の圧力レベルまで滅圧し、

前記ロードロックチャンパ内のウェハに対し、デガス処理を行い。

前記ロードロックチャンパから、前記ロードロックチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられるとともに、前記第1の圧力レベルより真空度の高い第2の圧力レベルまで減圧されたトランスファチャンパへ、前記一枚のウェハを転送し、

| 前記ロードロックチャンパと前記トランスファチャンパとの間を非通気状態とし、

前記トランスファチャンパから、前記トランスファチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように 設けられたプロセスチャンパへ、前記一枚のウェハを転送するマルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェ ハ郷入方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マルチチャンパウェハ処理システムに関し、特にそのウェハ換送装置に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、マルチチャンパウェハ処理システムの中には、ウェハ漁送装置として、ウェハを収納したウェハカセットを配置するロードステーションと、ウェハに薄膜形成等の表面処理を行う複数のプロセスチャンパを隣設し、ウェハの漁送を行うトランスファロボットを具備したトランスファチャンパと、ロードステーションとトランスファチャンパとの間に配置され、ロードステーションから受け取ったウェハを備えたものが知ったでは、

【0003】従来、このようなマルチチャンパウェハ処理システムのウェハ機送装置において、ロードステーションからプロセスチャンパにウェハを搬送するには、例えば25枚のウェハを収納したウェハカセットをロードステーションに設けたロードステーションロボットにより、そのウェバカセットからロードロックチャンパ内に用意したウェハカセットに一枚ずつ25枚全てのウェハを搬送する。その後、ロードロックチャンパ内を10-2~10-3 Torr程度の実空状態としてから、トランスファロボットによりロードロックチャンパとは別個に設けたウェハの

デガス用チャンパにウェハを一枚ずつ撤過し、デガスを 行った後、各プロセスチャンパにウェハを撤送してい る。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記従来のウェハ撤送 装置では、ロードロックチャンパは、真空室が一定で構 成され、25枚のウェハを一枚ずつ全てロードロックチャンパに撤送することができる容積となっている。ま た、ロードロックチャンパには、ロードロックチャンパ 内を10-2~10-3Torr程度に排気するラフボンブが接 続されている。さらに、ウェハは、ロードロックチャン パからトランスファチャンパを経てデガス用チャンパに 撤送され、デガスを行った後、このデガス用チャンパか らトランスファチャンパを経てプロセスチャンパに搬送 される構成となっている。

【0005】したがって、ロードステーションからプロセスチャンパにウェハを搬送するのに、プロセスチャンパでの処理時間よりも長時間を要し、スルーブットが悪かった。また、トランスファチャンパ内にガスコンタミネーションを生じ、それがプロセスチャンパ内へ影響して良好な表面処理を行うことができなかった。

【0006】さらに、ロードロックチャンパとデガス用チャンパとは別個に設けられているので、ロードロックチャンパの排気系とは別個にデガス用チャンパ独自の排気系を設けなければならず、マルチチャンパウェハ処理システムが高価になるという問題があった。

【0007】本発明は、かかる従来の問題点に鑑みてな されたもので、スループットが向上し、良好な表面処理 を行うことができる安価なマルチチャンパウェハ処理シ ステムを提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、本発明は、ウェハを収納 したウェハカセットを配置 するロードステーションと、ウェハに所定の処理を行う プロセスチャンパを隣設するとともに、ウェハの搬送を 行うトランスファロボットを具備したトランスファチャ ンパと、ロードステーションとトランスファチャンパと の間に配置され、ロードステーションから受け取ったウ ェハをトランスファロボットに受け渡すロードロックチ ヤンパとを備えたマルチチャンパウェハ処理システムの ウェハ撤送装置において、ロードロックチャンパの真空 室をロードステーションに接続される第1のロードロッ クチャンパとトランスファチャンパに接続される第2の ロードロックチャンパとに分割構成するとともに、第1 のロードロックチャンパと第2のロードロックチャンパ とを遮断および連通可能とし、第1のロードロックチャ ンパを第2のロードロックチャンパより小さな容積に形 成し、第2のロードロックチャンパを第1のロードロッ クチャンパより高英空とし、搭載した一枚のウェハを第 1のロードロックチャンパから第2のロードロックチャ

ンパに移動するステージを設け、ロードロックチャンパ にウェハのデガスを行うデガスヒータを設けた。

【0009】本発明のマルチチャンパウェン処理システ ムのウェハ搬送装置によれば、ロードステーションから 一枚のウェハをロードロックチャンバ内のステージで受 け取り、容積の小さな第1のロードロックチャンパで租 く排気する。次に、第1のロードロックチャンパと常時 高真空に排気している第2のロードロックチャンパとを **連通するとともに、ウェハを第2のロードロックチャン** パに移動させ、デガスヒータを作動させてウェハ表面上 のアウトガスのデガスを行う。その後、デガスを終了し たウェハをトランスファロボットに受け渡 し、トランス ファロボットはウェハをプロセスチャンパに搬送する。 【0010】プロセスチャンパでウェハの表面処理を行 っている間に、次に撤送するウェハのデガスは終了す る。また、トランスファチャンパ内へウェッルを搬送する 前にデガスは終了している。 したがって、 スループット が向上し、トランスファチャンパ側へのガスコンタミネ - ションがなくなり、良好な表面処理を行うことができ

【ロロ11】また、本発明のマルチチャンパウェハ処理 システムは、大気圧の圧力レベルの下に複数枚のウェハ を収納するためのウェハカセットが設けられるロードス テーションと、ロードステーションと選択的に通気状態 または非通気状態となるように設けられた。一枚のウェ ハを収納するに必要な容積を有する第1のロードロック チャンパと、第1のロードロックチャンパを第1の圧力 レベルまで選圧するための第1の排気手段と、第1の口 - ドロックチャンパと選択的に通気状態または非通気状 態となるように設けられた、第2のロードロックチャン バと、第2のロードロックチャンパを第1の圧力レベル より真空度の高い第2の圧力レベルまで減圧するための 第2の排気手段と、第2のロードロックチャンパと選択 的に通気状態または非通気状態となるように設けられ、 第2のロードロックチャンパから転送されてくるウェハ を所要のチャンパに転送するためのトランスファチャン パと、トランスファチャンパと選択的に通気状態または 非通気状態となるように設けられ、トランスファチャン パから転送されてくるウェハに対して所要の処理を行う プロセスチャンパとを備え、ロードステーションと第1 のロードロックチャンパとの間のウェハの転送およびチ ャンパ間のウェハの転送はウェハー枚ずつ行われること を特徴とする.

【ロロ12】マルチチャンパウェハ処理システムにおけるウェハ搬入方法は、大気圧の圧力レベルの下に複数枚のウェハを収納するためのウェハカセットが設けられるロードステーションから、ロードステーションと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられた、一枚のウェハを収納するのに必要な容積を有する第1のロードロックチャンパへ一枚のウェハを転送し、第1の

ロードロックチャンパを第1の圧力レベルまで選圧し、第1のロードロックチャンパから、第1のロードロックチャンパから、第1のロードロックチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられるとともに、第1の圧力レベルより真空度の高い第2の圧力レベルまで選圧された第2のロードロックチャンパから、第2のロードロックチャンパから、第2のロードロックチャンパから、第2のロードロックチャンパから、第2の圧力レベルより真空度の高い第3の圧力レベルまで選圧されたトランスファチャンパへ、一枚のウェハを転送し、第2のロードロックチャンパへ、一枚のウェハを転送し、第2のロードロックチャンパへ、一枚のウェハを転送し、第2のロードロックチャンパとのファチャンパから、トランスファチャンパとの間を非通気状態とし、トランスファチャンパから、トランスファチャンパと認识の状態または非通気状態となるように設けられたプロセスチャンパへ、一枚のウェハを転送することを特徴とする。

【ロロ13】マルチチャンパウェハ処理システムにおけ るウェハ搬出方法は、トランスファチャンパとロードス テーションとの間に配置されるアンロードロックチャン バを第1の圧力レベルとされる第1のアンロードロック チャンパと第2の圧力レベルとされる第2のアンロード ロックチャンパとで構成し、プロセスチャンパから、ブ ロセスチャンパと選択的に通気状態または非通気状態と なるように設けられたトランスファチャンパペー枚のウ ェハを転送し、プロセスチャンパとトランスファチャン。 パとの間を非通気状態とし、トランスファチャンパか ら、トランスファチャンパと選択的に通気状態または非 通気状態となるように設けられるとともに、トランスフ ァチャンパ内の圧カレベルより真空度の低い第2の圧力 レベルまで選圧された第2のアンロードロックチャンパ へ、一枚のウェハを転送し、第2のアンロードロックチ ャンパから、第2のアンロートロックチャンパと選択的 に通気状態または非通気状態となるように設けられた第 1のアンロードロックチャンパへ、一枚のウェハを転送 し、第1のアンロードロックチャンパと第2のアンロー ドロックチャンパとの間を非通気状態とし、第1のアン ロードロックチャンパの第1の圧力レベルを大気圧の圧 カレベルまで昇圧し、第1のアンロードロックチャンバ から、第1のアンロードロックチャンパと選択的に通気 状態または非通気状態となるように設けられたロードス テーションへ、一枚のウェハを転送することを特徴とす

【ロロ14】また、本発明のマルチチャンパウェハ処理システムは、大気圧の圧力レベルの下に複数枚のウェハを収納するためのウェハカセットが設けられるロードステーションと、ロードステーションと送択的に通気状態または非通気状態となるように設けられ、ロードステーションから転送されてくる一枚のウェハを収容するためのロードロックチャンパを、ロードロックチャンパを大気圧より真空度の高い圧力レベルまで減圧するための排

気手段と、ロードロックチャンパ内に収容されたウェハに対してデガス処理を行うデガス手段と、ロードロックチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられ、ロードロックチャンパから転送されてくる一枚のウェハを所要のチャンパに転送するためのトランスファチャンパと、トランスファチャンパと選択的に通気状態または非通気状態となるように設けられ、トランスファチャンパから転送されてくる一枚のウェハに対してい所要の処理を行うプロセスチャンパとを備えたことを特徴とする。

【ロロ15】このマルチチャンパウェハ処理システムに おけるウェハ搬入方法は、大気圧の圧力レベルの下に複 数枚のウェハを収納するためのウェハカセットが設けら れるロードステーションから、ロードステーションと選 択的に通気状態または非通気状態となるように設けられ た、一枚のウェハを収納するのに必要な容積を有するロ ードロックチャンパヘー枚のウェハを転送し、ロードス テーションとロードロックチャンパとの間を非通気状態 とし、ロードロックチャンパを大気圧の圧力レベルより 真空度の高い第1の圧力レベルまで減圧し、ロードロッ クチャンバ内のウェハに対し、デガス処理を行い、ロー ドロックチャンパから、ロードロックチャンパと選択的 に通気状態または非通気状態となるように設けられると ともに、第1の圧力レベルより真空度の高い第2の圧力 レベルまで選圧されたトランスファチャンパへ、一枚の ウェハを転送し、ロードロックチャンパとトランスファ チャンパとの間を非通気状態とし、トランスファチャン パから、トランスファチャンパと選択的に通気状態また は非通気状態となるように設けられたプロセスチャンバ へ、一枚のウェハを転送することを特徴とする。

[0016]

【発明の実施の形態】図 2 は、本実施形態のウェハ搬送 装置 1 を備えたマルチチャンパ型のスパッタリング装置 2 を平面的に示す概略構成図である。ウェハ搬送装置 1 は、ウェハ3を収納したウェハカセット4 を複数配置し たロードステーション5 と、ウェハ3に薄膜を形成する プロセスチャンパ6を複数騰設したトランスファチャン パ7 と、ロードステーション5 とトランスファチャンパ 7 との間にそれぞれ配置されたロードロックチャンパ8 およびアンロードロックチャンパ9 とから概略構成され ている。

【 00 1 7 】 ロードステーション5の中央部には、オリエンテーションフラットが形成されているウェハ3の位置決めを行うオリエンタ 1 1 が配置されている。ロードステーション5におけるオリエンタ 1 1 の両側には、それぞれ未処理のウェハ3を2 5枚収納したウェハカセット 4が複数配置されている。一方、ロードステーション5のロードロックチャンパ9側には、複数のウェハカセット4が配置された方向(ロードステーション5の長手方向)に沿って形成

された案内部 12 に案内されながら移動し、ウェハ3の 搬送を行うロードステーションロボット 13 が設けられ ている。ロードステーションロボット 13 は、途隔操作 により伸縮自在のリンク機構 13 e を備え、そのリンク 機構 13 e の先端には、ウェハ3を水平に搭載する細長 い平板状のブレード 13 bが取り付けられている。

【0018】ロードロックチャンバ8およびアンロードロックチャンバ9は、それぞれ大気圧の圧力レベルであるロードステーション5に連結されるとともに、10-7~10-8Torr程度に排気されるトランスファチャンバ7にスリットバルブ20を介して連結されている。スリットバルブ20は、ロードロックチャンバ8およびアンロードロックチャンバ9とトランスファチャンバ7とを連通したり、気密に遮断したりすることができるようになっている。

【0019】トランスファチャンパフには、ウェハ3の 撤送を行うトランスファロボット21が設けられている。トランスファロボット21は、トランスファチャンパフの中心に設置された支持軸21eと、この支持軸21eの外周に設けられた仲籍自在のリンク機構21bと、リンク機構21bの先端で水平に支持された細長い平板状のブレード21cとを備えている。ブレード21cは、リンク機構21bを遠隔操作することで、支持軸21eを中心として旋回および径方向に前後動し、その先端部をロードロックチャンパ8、プロセスチャンパ5およびアンロードロックチャンパ9内にそれぞれ差し入れることができ、ウェハ3を撤送することができるようになっている。

【0020】トランスファチャンパ7の周囲には、複数(本実施形態では5個)のプロセスチャンパ5がそれぞれスリットパルブ20を介して連結されている。本実施形態におけるプロセスチャンパ5は、スパッタリングによりウェハ3に薄膜形成の処理を行うもので、10~9Torv程度に排気される。スリットパルブ20は、プロセスチャンパ6とトランスファチャンパ7とを連通したり、気密に遮断したりすることができるようになっている。【0021】ロードロックチャンパ8は、図1~図7に示すように構成されている。図1は図3における1~1 線断面矢視図、図3はロードロックチャンパ8の平面図、図4は図3における1~1 V線断面矢視図、図5は図3における4~V線断面矢視図、図5および図7はそれぞれロードロックチャンパ8の動作状態を示す縦断面図である。

【00.22】ロードロックチャンバ8の真空室30は、ロードステーション5に接続される第1のロードロックチャンバ(第1の真空室)31と、トランスファチャンバ7にスリットバルブ20を介して接続される第2のロードロックチャンバ(第2の真空室)32とに分割構成されている。第1のロードロックチャンバ32は、第2のロードロックチャンバ32の上部に位置し、第2のロ

ードロックチャンパ32より小さな容後に形成されている。すなわち、第1のロードロックチャンパ31は、ウェハ3を一枚分収納することができ、短時間に減圧することができるように、0.5~0.8リットル程度の容はに形成されている。また、第1のロードロックチャンパ31には、図1に示すように、第2のロードロックチャンパ32の英空容器32eの側壁に形成した排気管路33を介してラフボンブ34が接続されており、第1のロードロックチャンパ31を50mTorr程度まで英空排気することができるようになっている。

【0023】一方、第2のロードロックチャンバ32は、約10リットルの容様に形成されている。第2のロードロックチャンバ32には、真空容器32eの底板に設けた関ロ部35を介してターボボンブ35およびラフボンブ37がそれぞれ接続されており、第2のロードロックチャンバ32を10~61orr程度まで真空排気することができるようになっている。

【0024】第1のロードロックチャンパ31と第2のロードロックチャンパ32とは、ウェハ3を一枚だけ搭載することができるように形成されたディスク状のステージ40により遮断および連通可能に構成されている。すなわち、第1のロードロックチャンパ31と第2のロードロックチャンパ32とは、円形の閉口部38により連通して構成されており、この開口部38をステージ40で気密に整ぐことにより両ロードロックチャンパ31、32を連断することができるようになっている。

【0025】ステージ40の下面中央部には、第2のロードロックチャンパ32の底面に取り付けられたステージ駆動装置41の上下駆動部41mの上端が固善されており、ステージ40は上下駆動部41mの上下動に伴って移動される。このステージ40の上下動により、第1のロードロックチャンパ32とを遮断および連選することができるとともに、ステージ40上の突起40mで支持したウェハ3を第1のロードロックチャンパ32に移動させることができるようになっている。

【0026】第1のロードロックチャンバ31の真空容器31aの上板の一部には、円形の開口部39が形成されており、この開口部39は、石英からなる透明な円板状の窓51により気密に開塞されている。窓51上には、リング部材52を介して逆有底円筒状のカバー53が設けられている。そして、窓51とリング部材52とカバー53とで形成される密閉空間には、ウェハ3のデガス用のデガスヒータ54が配設されている。このデガスヒータ54は、ハロゲンランプからなり、ランプ加熱方式となっている。

【0027】第1のロードロックチャンパ31の真空容器31a、窓51、リング部材52、カバー53およびデガスヒータ54によりロードロックカバーユニット5

○が構成されている。このロードロックカバーユニット50は、ステージ駆動装置41の下部に設けられたユニット駆動装置60により上下に駆動される。すなわち、図4に示すように、ユニット駆動装置60の上下駆動軸60のの下端には、水平軸61が連結されている。2本の支持軸62の下端が固着されている。これら支持軸62の下端が固着されている。これら支持軸62は、第2のロードロックチャンバ32の実空容器328 壁内に設けられた上下の各スライダ63を貫通し、支持軸62の上端は、第1のロードロックチャンバ31の真空容器318の下面に固善されている。これにより、ロードロックカバーユニット50全体は、支持軸62に支持され、第2のロードロックチャンバ32と分離して上下に移動できるようになっている。

【0028】ロードロックカバーユニット50の上動により、ウェハ3をステージ40に搭載できるようになる。ロードステーション5からのウェハ3の搬送レベルAは、図6に示すように、開口部38を開塞するように移動したステージ40の突起40gのやや上方位置となる。また、図5から図7に示すように、第2のロードロックチャンバ32の真空容器32gの側壁には、スリットバルブ20を介してトランスファチャンバ7へウェハ3を搬送するための出入口32bが形成されており、この出入口32bの位置がトランスファチャンバ7へのウェハ3の搬送レベルBとなる。

【0029】図 8はアンロードロックチャンバ9の縦断面図である。

【0030】図 8において、アンロードロックチャンパ9は、ロードロックチャンパ8と同様に、真空室70が、ロードステーション5に接続される第1のアンロードロックチャンパ(第1の真空室) 71と、トランスファチャンパ7にスリットパルプ20を介して接続される第2のアンロードロックチャンパ(第2の真空室) 72とに分割構成されている。第1のアンロードロックチャンパ72の上部に位置し、第2のアンロードロックチャンパ72より小さな容積に形成されている。すなわち、第1のアンロードロックチャンパ71は、0.5~0.8リットル程度の容積に形成されており、ロードステーション5側へウェハ3を受け渡す際には、室内は最終的に大気圧とされる。

【0031】一方、第2のアンロードロックチャンパ72は、約10リットルの容核に形成されている。また、図示は省略したが、第2のアンロードロックチャンパ72には、真空容器の底板に設けた関口部を介してポンプが接続されており、第2のアンロードロックチャンパ72を10-6forr程度まで真空排気することができるようになっている。

【0032】第1のアンロードロックチャンパ71と第 2のアンロードロックチャンパ72とは、ロードロック チャンパ8のステージ40と同様に、ウェハ3を一枚だけ搭載することができるように形成されたディスク状のステージ80により遮断および連通可能に構成されている。すなわち、第1のアンロードロックチャンパ71と第2のアンロードロックチャンパ72とは、円形の開口部73により連通して構成されており、この開口部73をステージ80で気密に座ぐことにより両アンロードロックチャンパ71、72を遮断することができるようになっている。

【0033】ステージ80の下面中央部には、第2のアンロードロックチャンパ72の底面に取り付けられたステージ駆動装置81の上下駆動部81sの上端が固善されており、ステージ80は上下駆動部81sの上下動に伴って移動される。このステージ80の上下動により、第1のアンロードロックチャンパ71と第2のアンロードロックチャンパ72とを遮断および速通することができるとともに、ステージ80上の突起80sで支持したウェハ3を第2のアンロードロックチャンパ72から第1のアンロードロックチャンパ71に移動させることができるようになっている。第2のアンロードロックチャンパ72の真空整器72sの側壁には、トランスファチャンパ7からウェハ3が搬入される出入ロ72bが形成されている。

【0034】また、プロセスチャンパら内で表面処理後のウェハ3は、スパッタされて高温になっているので、ウェハ3を冷却すべく、第1のアンロードロックチャンパ71の真空容器 71 a およびステージ80の内部には、それぞれ冷却水による冷却機構 90が設けられている。

【ロロ35】このような構成の本実施形態のウェハ搬送 装置1によりウェハ3を搬送するには、まず、大気圧の 圧力レベルであるロードステーション5内にウェハ3を 25枚収納したウェハカセット4を用意する。そして、 ロードステーションロボット13によりウェハ3を取り 出し、オリエンタ11にウェハ3を入れてオリエンテー ションフラットに基づきウェハ3の位置決めを行う。次 に、ロードステーションロボット13によりウェハ3を ロードロックチャンパ8の第1のロードロックチャンパ 3 1内に搬送する。このとき、ロードロックカバーユニ ット50は、ユニット駆動装置60(図4参照)の駆動・ により支持軸62に支持されながら上方に移動し、第2 のロードロックチャンパ32と分離されてウェハ3の搬 送路を形成する。ステージ40の突起408上にウェハ 3が受け渡されてから、ロードロックカバーユニット5 □は、ユニット駆動装置6回の駆動によりステージ4回 を益するように第2のロードロックチャンパ32の真空 容器328上面まで下動し、第1のロードロックチャン バ31を構成する。

【ロロ35】その後、ロードステーション5と第1のロードロックチャンパ31とを非通気状態とし、第1のロ

ードロックチャンパ31を、ラフボンブ34により5~6秒で50mTorrに排気する。次に、ステージ駆動装置41の駆動によりステージ40を下動させ、ウェハ3を第2のロードロックチャンパ32内に移動する。このとき、第2のロードロックチャンパ32内は、ラフボンブ37よびターボボンブ34によりすでに10-6Torrまで真空排気されており、この第2のロードロックチャンパ32と第1のロードロックチャンパ31とは連通される。これと同時、つまり第1のロードロックチャンパ31が6第2のロードロックチャンパ32へのウェハ3の

転送を開始した後、デガスヒータ54を作動させ、ウェハ3表面上のアウトガスのデガスを行う。

【0037】ここで、あるプロセスチャンパ6での処理時間を、例えば60秒であるとすると、表面処理後のウェハ3を取り出したプロセスチャンパ6内に効率よく直ちに新たなウェハ3を搬送するには、トランスファロボット21のウェハ3搬送に要する時間が10秒程度であるので、処理時間から搬送時間を引いたわ50秒の間にデガスまで終了していればよい。第1のロードロックチャンパ31での排気時間は5~6秒であり、ステージ40の移動時間が4秒程度であるので、50秒~6秒~4秒=40秒以内にデガスが終了していればよいこととなる。デガスを行うには20秒程度あればよいので、本実施形態では、十分にデガスを行うことができる。

【ロロ38】 デガス終了後は、第2のロードロックチャンパ32とトランスファチャンパ7とを通気状態とし、トランスファチャンパ7のトランスファロボット21を駆動させ、ブレード21eによりステージ40上のウェハ3を受け取り、ウェハ3をトランスファチャンパ7内に撤送した後、第2のロードロックチャンパ32とトランスファチャンパ7とを非通気状態とし、スリットパルブ20を開いて所定のプロセスチャンパ6内で浮膜を形成する。その後、プロセスチャンパ6内で浮膜を形成する。

【0039】プロセスチャンパ6で表面処理が施された ウェハ3は、プロセスチャンパ6とドランスファチャン パフとを通気状態とした後、トランスファロボット21 によりプロセスチャンパ6からトランスファチャンパフ 内に搬送し、さらにトランスファチャンパフと第2のア ンロードロックチャンパ72とを通気状態とし、出入口 7 2 bを介して第2のアンロードロックチャンパ7 2内 に搬送する。 このとき、第2のアンロードロックチャン パフ2は、図示を省略したポンプにより1 Dー6Torr程度 に排気されている。第2のアンロードロックチャンパ7 2でステージ80上に受け取ったウェハ3は、トランス ファチャンパ7 と第2のアンロードロックチャンパ7 2 とを非通気状態とした後、ステージ駆動装置81の駆動 によるステージ8 0の上動により、第1のアンロードロ ックチャンパ内71に転送する。ステージ80の移動に より、第1のアンロードロックチャンパ71と第2のア

ンロードロックチャンパ72とは、気密に遮断される。【0040】次に、第1のアンロードロックチャンパ71内を変素等のガスの供給により大気圧までベントし、熱伝導の効率を高めて冷却機構90によりウェハ3を冷却する。これらの動作をロードロックチャンパ8と同様に、約50秒程度で終了させ、その後完全に大気開放して、更に冷却しながらロードステーション5のロードステーションロボット13により、ウェハ3を更すウェハカセット4内に収納する。この場合、ウェハ3を戻すウェハカセット4は、処理前にウェハ3が収納されていたウェハカセット4に戻してもよく、また別のウェハカセット4に収納するようにしてもよい。

【0041】以上のように、本実施形態のウェハ搬送装置1によれば、ロードロックチャンパ8の真空室30は、第1のロードロックチャンパ31と第2のロードロックチャンパ32とに分割され、2重のロードロックとなっているので、トランスファチャンパ7内への大気の持ち込みは、激減される。さらに、プロセスチャンパ6での処理時間中にロードロックチャンパ8内でウェハ3のデガスまで行うので、スループットを落とすことなく、トランスファチャンパ7個へのガスコンタミネーションを従来のウェハ搬送装置の1/100,000程度にすることができる。

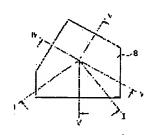
【0042】また、デガス用のチャンパを別倒に設ける必要がなく、それに伴ってデガス用の排気系を設ける必要もないので、安価となる。

[0043]

【発明の効果】以上のように、本発明の半導体製造装置のウェハ搬送装置によれば、スループットが向上し、ガスコンタミネーションによる表面処理への悪影響を防ぐことができ、半導体製造装置を安価に構成することができる。

【図面の簡単な説明】

[図3]



【図1】本発明の一実施形態のウェハ搬送装置のロードロックチャンパを示すもので、図3における1-1線断面矢視図である。

【図2】同実施形態のウェハ搬送装置を備えたスパッタ リング装置を示す概略構成図である。

【図3】同実施形態のウェハ撤送装置のロードロックチャンパを示す平面図である。

【図4】同実施形態のウェハ撤送装置のロードロックチャンパを示すもので、図3における I V- I V線断面矢 視図である。

【図5】同実施形態のウェハ線送装置のロードロックチャンパを示すもので、図3におけるVーV線断面失視図である。

【図5】同実施形態のウェハ搬送装置のロードロックチャンパを示す縦断面図である。

【図7】同実施形態のウェハ搬送装置のロードロックチャンパを示す縦断面図である。

【図8】同実施形態のウェハ搬送装置のアンロードロックチャンパを示す縦断面図である。

【符号の説明】

1…ウェハ搬送破置、2…スパッタリング破置、3…ウェハ、4…ウェハカセット、5…ロードステーション、6…プロセスチャンパ、7…トランスファチャンパ、8 …ロードロックチャンパ、9…アンロードロックチャンパ、13…ロードステーションロボット、20…スリットパルブ、21…トランスファロボット、30…真空室、31…第1のロードロックチャンパ、32…第2のロードロックチャンパ、40…ステージ、41…ステージ駆動装置、50…ロードロックカパーユニット、54 …デガスヒータ、60…ユニット駆動装置、71…第1のアンロードロックチャンパ、72…第2のアンロードロックチャンパ

[図5]

